

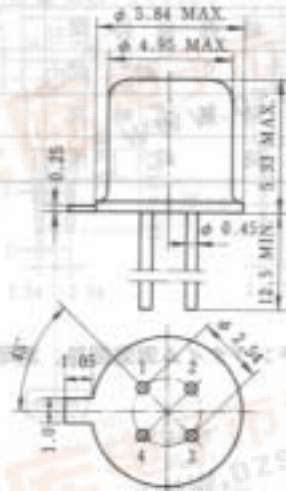
3SJ11A

3SJ11A

Pチャンネルエンハンスメント形MOS電界効果トランジスタ P-Channel Enhancement
 高入力インピーダンス直流増幅用 MOS Field-Effect Transistor
 通信工業用 High Input Impedance DC Amplifier
 Industrial Use

3SJ11AはPチャンネルエンハンスメントモードMOS-FETでMOS構造により高入力インピーダンスを示し、エンハンスメントモードであるためスイッチとしても応用が可能で、各種計測機器制御機器の高入力インピーダンス増幅およびアナログスイッチとして最適です。

外形図/PACKAGE DIMENSIONS
 (Unit : mm)



- ゲートしゃ断電流が小さい。
 Small I_{GSS} $I_{GSS} : -10 \text{ pA MAX. (} V_{GS} = -10 \text{ V)}$
- カットオフ電圧が低い。
 Low cutoff voltage $V_{GS(off)} : -2.5 \text{ V TYP.}$
- オン抵抗が小さい。
 Small $r_{DS(on)}$ $r_{DS(on)} : 170 \text{ } \Omega \text{ TYP.}$

絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)

| 項目 | 略号 | 定格 | 単位 |
|-------------|-----------|------------|------------------|
| ドレイン・ソース間電圧 | V_{DS} | -30 | V |
| ゲート・ソース間電圧 | V_{GS} | -40 | V |
| ドレイン電流 | I_D | -50 | mA |
| 全損失 | P_T | 225 | mW |
| チャネル部温度 | T_{ch} | 100 | $^\circ\text{C}$ |
| 保存温度 | T_{stg} | -65 ~ +150 | $^\circ\text{C}$ |

電極接続

1. Source
2. Gate
3. Drain
4. Sub. (Case)

EIAJ : TC-7, TB-9C
 JEDEC : TO-206MD(TO-72)
 IEC : C7, B12

電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)

| 項目 | 略号 | 条件 | MIN. | TYP. | MAX. | 単位 |
|--------------|---------------|--|------|------|------|---------------|
| ゲートしゃ断電流 | I_{GSS} | $V_{DS} = -10 \text{ V, } V_{GS} = V_{DS} = 0$ | | | -10 | μA |
| ドレイン漏れ電流 | I_{DSS} | $V_{GS} = -10 \text{ V, } V_{DS} = V_{GS} = 0$ | | | -10 | nA |
| カットオフ電圧 | $V_{GS(off)}$ | $V_{DS} = -10 \text{ V, } I_D = -10 \text{ } \mu\text{A, } V_{GS} = 0$ | -1.5 | -2.5 | -3.5 | V |
| オン抵抗 | $r_{DS(on)}$ | $V_{GS} = -10 \text{ V, } V_{DS} = -1.0 \text{ V, } V_{GS} = 0$ | | 170 | 500 | Ω |
| 小信号順伝達アドミタンス | $ y_{fs} $ | $V_{DS} = -10 \text{ V, } I_D = -1.0 \text{ mA}$ | 0.5 | 1.0 | | mS |
| 小信号出力アドミタンス | $ y_{os} $ | $V_{GS} = 0, f = 1.0 \text{ kHz}$ | | 70 | | μS |
| 小信号入力容量 | C_{iss} | $V_{DS} = -10 \text{ V, } V_{GS} = 0$ | | 8.0 | | pF |
| 小信号出力容量 | C_{oss} | $V_{GS} = 0, f = 1.0 \text{ MHz}$ | | 3.5 | | pF |

